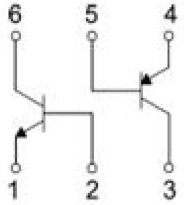
SOT-363 Bipolar Transistor 双极型三极管



■Features 特点

NPN+PNP High Voltage 高压

■Absolute Maximum Ratings 最大额定值

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rat 额定值	Unit 单位
Collector-Base Voltage 集电极基极电压	V_{CBO}	180/-160	V
Collector-Emitter Voltage 集电极发射极电压	V_{CEO}	160/-150	V
Emitter-Base Voltage 发射极基极电压	V_{EBO}	6/-5	V
Collector Current 集电极电流	I_C	200/-200	mA
Power dissipation 耗散功率	$P_C(T_a=25℃)$	200	mW
Thermal Resistance Junction-Ambient 热阻	$R_{\Theta JA}$	625	℃/W
Junction and Storage Temperature 结温和储藏温度	T_J,T_{stg}	-55to+150℃	

■Device Marking 产品打标

Marking	KNM

■Electrical Characteristics 电特性(NPN)

(T_A=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明，温度为 25℃)

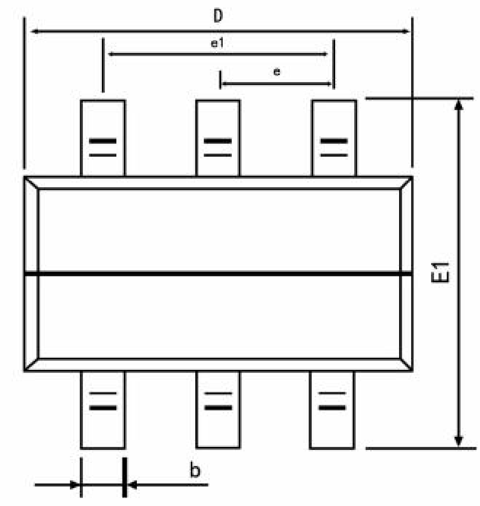
Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极基极击穿电压(I_C=100uA，I_E=0)	BV_{CBO}	180	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极发射极击穿电压(I_C=1mA，I_B=0)	BV_{CEO}	160	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极基极击穿电压(I_E=10uA，I_C=0)	BV_{EBO}	6	—	—	V
Collector-Base Leakage Current 集电极基极漏电流(V_{CB}=120V，I_E=0)	I_{CBO}	—	—	50	nA
Emitter-Base Leakage Current 发射极基极漏电流(V_{EB}=4V，I_C=0)	I_{EBO}	—	—	50	nA
DC Current Gain 直流电流增益(V_{CE}=5V，I_C=1mA)	$H_{FE}(1)$	80	—	—	
DC Current Gain 直流电流增益(V_{CE}=5V，I_C=10mA)	$H_{FE}(2)$	100	—	300	
DC Current Gain 直流电流增益(V_{CE}=5V，I_C=50mA)	$H_{FE}(3)$	30	—	—	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极发射极饱和压降(I_C=10mA，I_B=1mA) (I_C=50mA，I_B=5mA)	$V_{CE(sat)}$	—	—	0.15 0.2	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基极发射极饱和压降(I_C=10mA，I_B=1mA) (I_C=50mA，I_B=5mA)	$V_{BE(sat)}$	—	—	1 1	V
Transition Frequency 特征频率(V_{CE}=10V，I_C=10mA，f=100MHz)	f_T	100	—	300	MHz
Noise Figure 噪声系数(V_{CE}=5V，I_C=200μA，f=1KHz)	NF	—	—	8	db
Output Capacitance 输出电容(V_{CB}=10V，I_E=0, f=1MHz)	Cob	—	6	—	pF

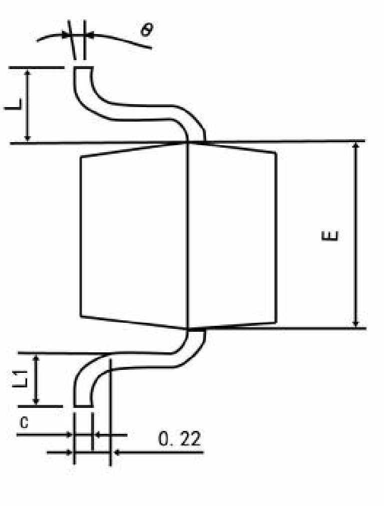
■Electrical Characteristics 电特性(PNP)

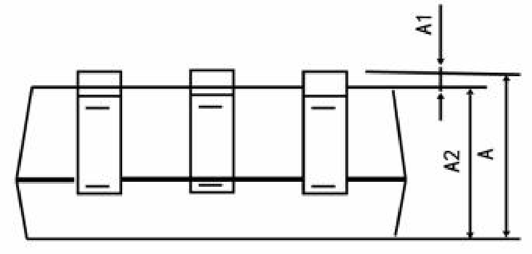
(T_A=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明，温度为 25℃)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极基极击穿电压(I_C= -100μA，I_E=0)	BV_{CBO}	-160	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极发射极击穿电压(I_C= -1mA，I_B=0)	BV_{CEO}	-150	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极基极击穿电压(I_E= -10μA，I_C=0)	BV_{EBO}	-5	—	—	V
Collector-Base Leakage Current 集电极基极漏电流(V_{CB}= -120V，I_E=0)	I_{CBO}	—	—	-50	nA
Emitter-Base Leakage Current 发射极基极漏电流(V_{EB}= -3V，I_C=0)	I_{EBO}	—	—	-50	nA
DC Current Gain 直流电流增益(V_{CE}= -5V，I_C= -1mA)	$H_{FE}(1)$	50	—	—	
DC Current Gain 直流电流增益(V_{CE}= -5V，I_C= -10mA)	$H_{FE}(2)$	100	—	300	
DC Current Gain 直流电流增益(V_{CE}= -5V，I_C= -50mA)	$H_{FE}(3)$	50	—	—	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极发射极饱和压降(I_C= -10mA，I_B= -1mA) (I_C= -50mA，I_B= -5mA)	$V_{CE(sat)}$	—	—	-0.2 -0.5	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基极发射极饱和压降(I_C= -10mA，I_B= -1mA) (I_C= -50mA，I_B= -5mA)	$V_{BE(sat)}$	—	—	-1 -1	V
Transition Frequency 特征频率(V_{CE}= -10V，I_C= -10mA)	f_T	100	—	300	MHz
Noise Figure 特征频率(V_{CE}= -5V，I_C= -200μA，f=1KHz)	NF	—	—	8	db
Output Capacitance 输出电容(V_{CB}= -5V，I_E=0, f=1MHz)	Cob	—	6	—	pF

■Dimension 外形封装尺寸







Symbol	Dimension in Millimeters	
	Min	Max
A	0.900	1.100
A1	0.000	0.100
A2	0.900	1.000
b	0.150	0.350
c	0.080	0.150
D	2.000	2.200
E	1.150	1.350
E1	2.150	2.450
e	0.650 TYP	
e1	1.200	1.400
L	0.525 REF	
L1	0.260	0.460
θ	0°	8°